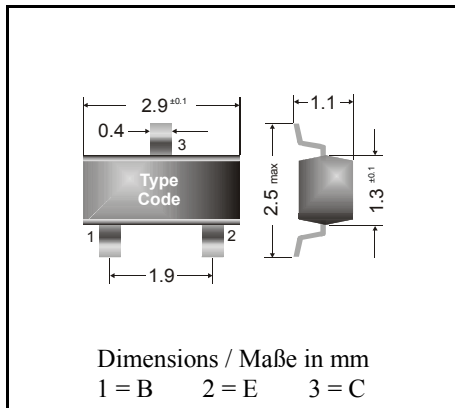


PNP

**Surface mount Si-Epitaxial Planar Transistors**  
**Si-Epitaxial Planar Transistoren für die Oberflächenmontage**

PNP



Power dissipation – Verlustleistung 250 mW

Plastic case SOT-23  
Kunststoffgehäuse (TO-236)

Weight approx. – Gewicht ca. 0.01 g

Plastic material has UL classification 94V-0  
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertStandard packaging taped and reeled  
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle**Maximum ratings ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )****Grenzwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )**

			<b>BCW 67</b>	<b>BCW 68</b>
Collector-Emitter-voltage	B open	$-V_{CE0}$	32 V	45 V
Collector-Base-voltage	E open	$-V_{CB0}$	45 V	60 V
Emitter-Base-voltage	C open	$-V_{EB0}$	5 V	
Power dissipation – Verlustleistung		$P_{tot}$	250 mW <sup>1)</sup>	
Collector current – Kollektorstrom (DC)		$-I_C$	800 mA	
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		$-I_{CM}$	1000 mA	
Base current – Basis-Spitzenstrom		$-I_B$	100 mA	
Peak Base current – Basis-Spitzenstrom		$-I_{BM}$	200 mA	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_j$	150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_S$	- 65...+ 150°C	

**Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )****Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )**

			<b>Min.</b>	<b>Typ.</b>	<b>Max.</b>
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom					
$I_E = 0, -V_{CB} = 32\text{ V}$	BCW 67	$-I_{CB0}$	–	–	20 nA
		$-I_{CB0}$	–	–	20 µA
$I_E = 0, -V_{CB} = 45\text{ V}$	BCW 68	$-I_{CB0}$	–	–	20 nA
		$-I_{CB0}$	–	–	20 µA
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom					
$I_C = 0, -V_{EB} = 4\text{ V}$		$-I_{EB0}$	–	–	20 nA

<sup>1)</sup> Mounted on P.C. board with 3 mm<sup>2</sup> copper pad at each terminal  
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß

Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )

		Min.	Typ.	Max.
Collector saturation volt. – Kollektor-Sättigungssp. <sup>1)</sup>				
- $I_C = 100\text{ mA}$ , - $I_B = 10\text{ mA}$	- $V_{CEsat}$	–	–	300 mV
- $I_C = 500\text{ mA}$ , - $I_B = 50\text{ mA}$	- $V_{CEsat}$	–	–	700 mV
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung <sup>1)</sup>				
- $I_C = 100\text{ mA}$ , - $I_B = 10\text{ mA}$	- $V_{BEsat}$	–	–	1.25 V
- $I_C = 500\text{ mA}$ , - $I_B = 50\text{ mA}$	- $V_{BEsat}$	–	–	2 V
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis <sup>1)</sup>				
- $V_{CE} = 10\text{ V}$ - $I_C = 100\ \mu\text{ mA}$	BCW 67A / 68F	$h_{FE}$	35	–
	BCW 67B / 68G	$h_{FE}$	50	–
	BCW 67C / 68H	$h_{FE}$	80	–
- $V_{CE} = 1\text{ V}$ - $I_C = 10\text{ mA}$	BCW 67A / 68F	$h_{FE}$	75	–
	BCW 67B / 68G	$h_{FE}$	120	–
	BCW 67C / 68H	$h_{FE}$	180	–
- $V_{CE} = 1\text{ V}$ - $I_C = 100\text{ mA}$	BCW 67A / 68F	$h_{FE}$	100	160
	BCW 67B / 68G	$h_{FE}$	160	250
	BCW 67C / 68H	$h_{FE}$	250	350
- $V_{CE} = 2\text{ V}$ - $I_C = 500\text{ mA}$	BCW 67A / 68F	$h_{FE}$	35	–
	BCW 67B / 68G	$h_{FE}$	60	–
	BCW 67C / 68H	$h_{FE}$	100	–
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz				
- $V_{CE} = 5\text{ V}$ , - $I_C = 50\text{ mA}$ , $f = 100\text{ MHz}$	$f_T$	–	200 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität				
- $V_{CB} = 10\text{ V}$ , $I_E = i_c = 0$ , $f = 1\text{ MHz}$	$C_{CB0}$	–	6 pF	–
Emitter-Base Capacitance – Emitter-Basis-Kapazität				
- $V_{EB} = 0.5\text{ V}$ , $I_C = i_c = 0$ , $f = 1\text{ MHz}$	$C_{EB0}$	–	60 pF	–
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		$R_{thA}$	420 K/W <sup>2)</sup>	
Recommended complementary NPN-transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren		BCW 65, BCW 66		
Marking – Stempelung	BCW 67A = DA	BCW 67B = DB	BCW 67C = DC	
	BCW 68F = DF	BCW 68G = DG	BCW 68H = DH	

<sup>1)</sup> Tested with pulses  $t_p = 300\ \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300\ \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$

<sup>2)</sup> Mounted on P.C. board with  $3\text{ mm}^2$  copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit  $3\text{ mm}^2$  Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß